



安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD.

FMMT619

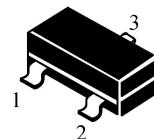
SOT-23 Bipolar Transistor 双极型三极管

■ Features 特点

NPN Low equivalent on-resistance 低等效电阻

SOT-23

1. BASE
2. Emitter
3. COLLECTOR



■ Absolute Maximum Ratings 最大额定值

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Rating 额定值	Unit 单位
Collector-Base Voltage 集电极基极电压	V_{CBO}	50	V
Collector-Emitter Voltage 集电极发射极电压	V_{CEO}	50	V
Emitter-Base Voltage 发射极基极电压	V_{EBO}	5	V
Collector Current 集电极电流	I_C	2000	mA
Power dissipation 耗散功率	$P_C(T_a=25^\circ C)$	250	mW
Thermal Resistance Junction-Ambient 热阻	$R_{\theta JA}$	500	°C/W
Junction and Storage Temperature 结温和储藏温度	T_J, T_{stg}	-55 to +150 °C	

■ Device Marking 产品打标

FMMT619=619



安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD.

FMMT619

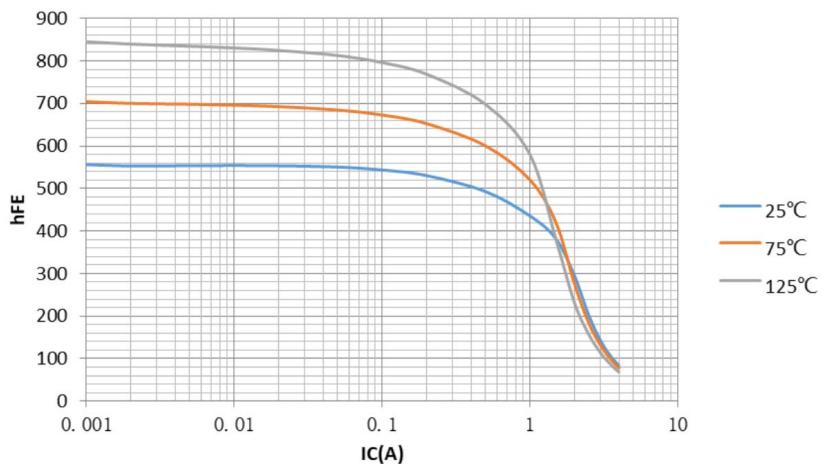
■ Electrical Characteristics 电特性

($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为 25°C)

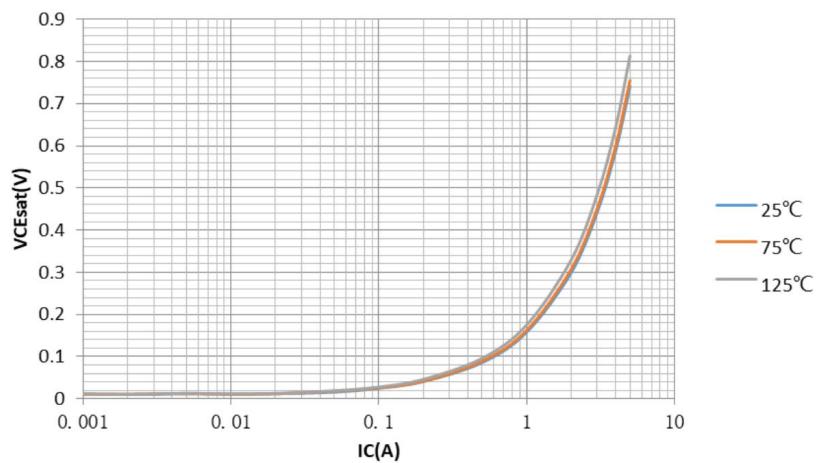
Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Min 最小值	Type 典型值	Max 最大值	Unit 单位
Collector-Base Breakdown Voltage 集电极基极击穿电压($I_C=100\mu\text{A}$, $I_E=0$)	BV_{CBO}	50	—	—	V
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集电极发射极击穿电压($I_C=10\text{mA}$, $I_B=0$)	BV_{CEO}	50	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 发射极基极击穿电压($I_E=100\mu\text{A}$, $I_C=0$)	BV_{EBO}	5	—	—	V
Collector-Base Leakage Current 集电极基极漏电流($V_{\text{CB}}=30\text{V}$, $I_E=0$)	I_{CBO}	—	—	1	μA
Collector-Emitter Leakage Current 集电极发射极漏电流($V_{\text{CE}}=30\text{V}$, $V_{\text{BE}}=-0.5\text{V}$)	I_{CEX}	—	—	1	μA
Emitter-Base Leakage Current 发射极基极漏电流($V_{\text{EB}}=5\text{V}$, $I_C=0$)	I_{EBO}	—	—	1	μA
DC Current Gain($V_{\text{CE}}=2\text{V}$, $I_C=200\text{mA}$) 直流电流增益($V_{\text{CE}}=2\text{V}$, $I_C=2000\text{mA}$)	H_{FE}	300 150	—	450	
Collector-Emitter Saturation Voltage 集电极发射极饱和压降 ($I_C=1500\text{mA}$, $I_B=50\text{mA}$) ($I_C=2500\text{mA}$, $I_B=150\text{mA}$)	$V_{\text{CE(sat)}}$	—	—	0.25 0.35	V
Base-Emitter Saturation Voltage 基极发射极饱和压降 ($I_C=2000\text{mA}$, $I_B=100\text{mA}$)	$V_{\text{BE(sat)}}$	—	—	1.1	V
Transition Frequency 特征频率($V_{\text{CE}}=10\text{V}$, $I_C=50\text{mA}$)	f_T	150	—	—	MHz

■ Typical Characteristic Curve 典型特性曲线

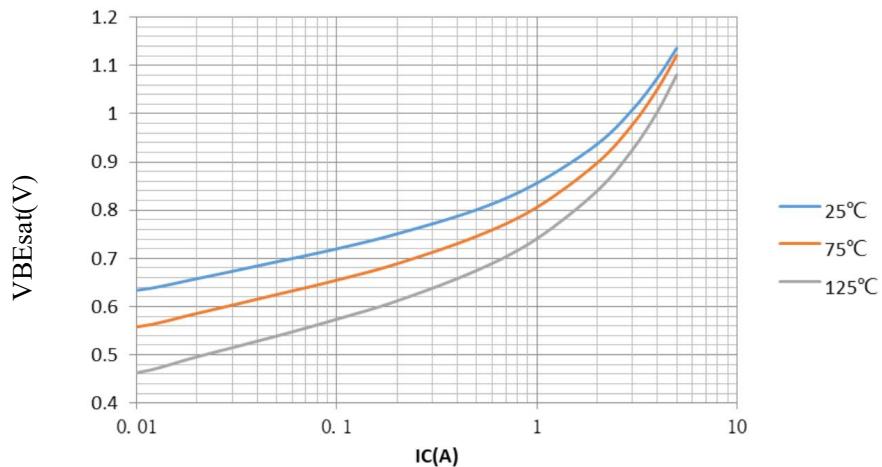
h_{FE} -- I_C



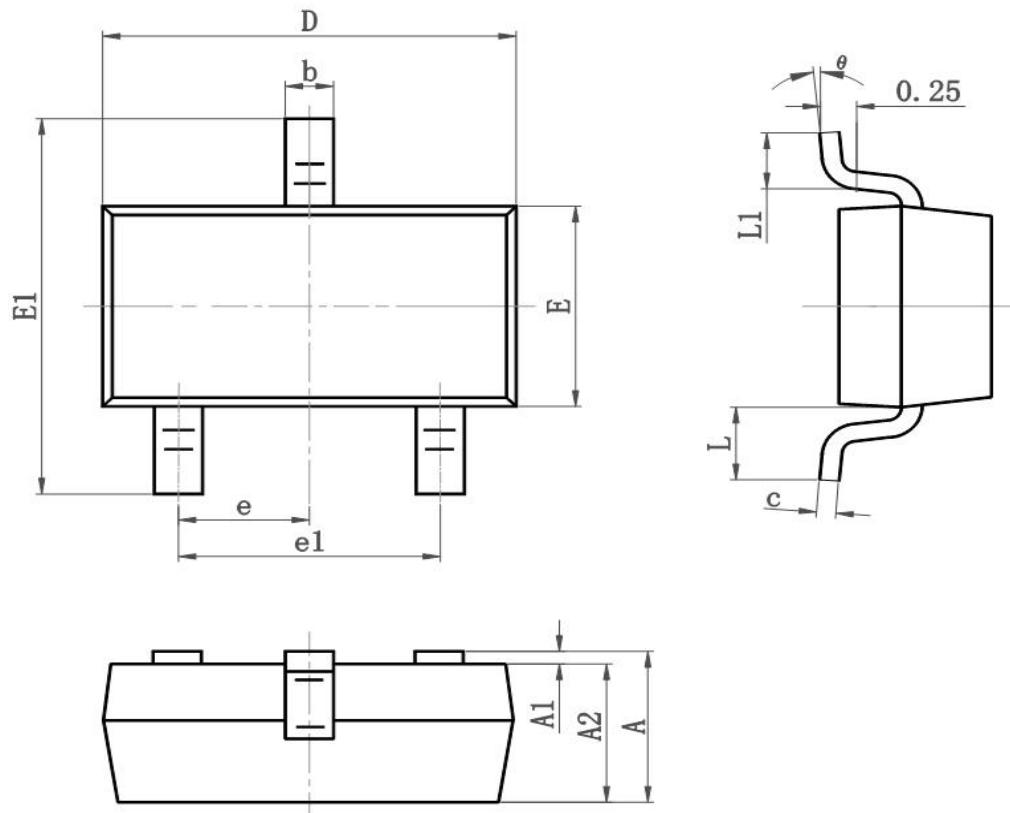
$V_{CE(sat)}$ -- I_C



$V_{BE(sat)}$ -- I_C



■ Dimension 外形封装尺寸



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	0.900	1.150	0.035	0.045
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	0.900	1.050	0.035	0.041
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.080	0.150	0.003	0.006
D	2.800	3.000	0.110	0.118
E	1.200	1.400	0.050	0.055
E1	2.250	2.550	0.089	0.100
e	0.950TYP		0.037TYP	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.550REF		0.022REF	
L1	0.300	0.500	0.012	0.020
θ	0°	8°	0°	8°